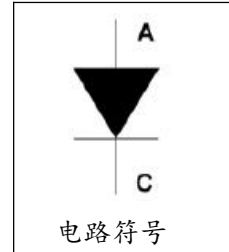


KD1520

特点:

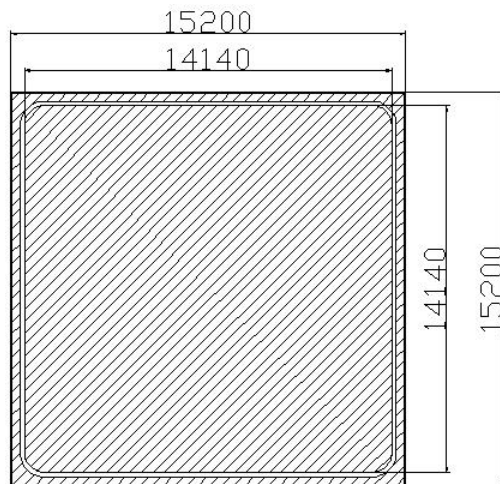
- 阻断电压高 (>2000V)
- 低正向压降; 高通态电流 I_F
- 复合钝化台面结构芯片, 高温漏电小, 可靠性高



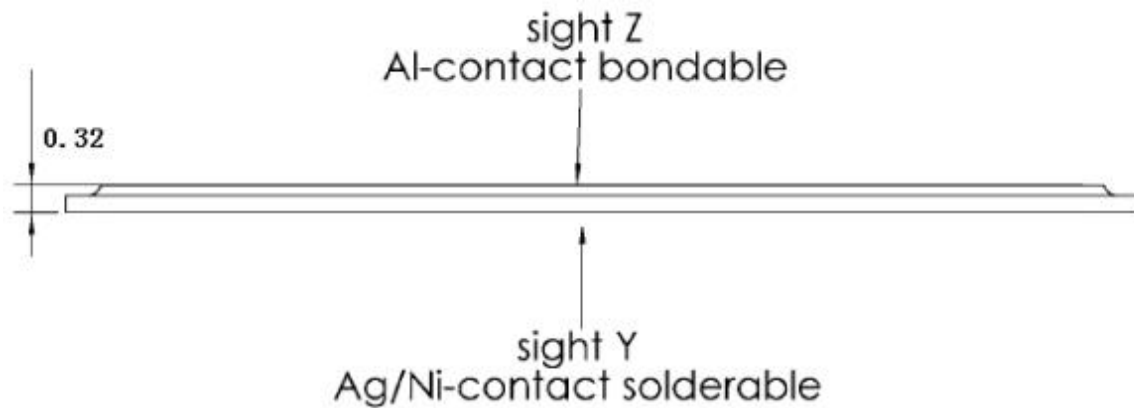
应用:

主要应用于各类电力电子模块等。

外形尺寸图:



单位: 微米



单位: 毫米

极限值

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{RRM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}, I_R=0.1\text{mA}$			2000	V
V_{RSM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}, I_R=0.1\text{mA}$			2200	V
I^2t	$T_j=125, t=10\text{ms}, \sin 180^{\circ}$	-	-	72200	A^2S
$I_{F(AV)}$	$T_s=80^{\circ}\text{C}, T_j=125^{\circ}\text{C}$			270	A
$I_{F(DC)}$	$T_s=80^{\circ}\text{C}, T_j=125^{\circ}\text{C}$			330	A
I_{FSM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}, t=10\text{ms}, \sin 180^{\circ}$			5000	A
	$T_j=125^{\circ}\text{C}, t=10\text{ms}, \sin 180^{\circ}$			3800	
T_j		-		150	$^{\circ}\text{C}$

电特性

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
I_{RRM}	$V_{RRM}, T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	-	0.1	mA
	$V_{RRM}, T_j=120^{\circ}\text{C}$	-	-	2.2	
V_F	$T_j=25^{\circ}\text{C}, I_F=245\text{A}$	-	-	1.21	V
	$T_j=125^{\circ}\text{C}, I_F=245\text{A}$			1.1	V
$V_{(TO)}$	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	0.85	V
R_T	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	-		0.7	$\text{m}\Omega$
T_{rr}	$T_j=25^{\circ}\text{C}, \pm 1\text{A}$	-	-	400	μS